

性能特点

- 频率范围：DC-40 GHz
- 可选固定衰减量：1、2、3 dB
- 耐受功率：+27 dBm
- 输入/输出阻抗：50 Ω
- 芯片尺寸：1.15X0.65X0.1 mm
- 100%在片测试

产品介绍

ZXA6151是一种GaAs 3态“1dB”可选宽带组合衰减器芯片 (Die), 衰减范围覆盖1/2/3dB, 在DC-40GHz频率范围内拥有优良的衰减平坦度和端口驻波特性, 适用于微波混合电路和多芯片模块。芯片采用了片上通孔金属化工艺, 保证了良好的接地。芯片背面进行了金属化处理, 适用于共晶焊接或导电胶粘接工艺。

电气性能参数 (TA = +25℃)

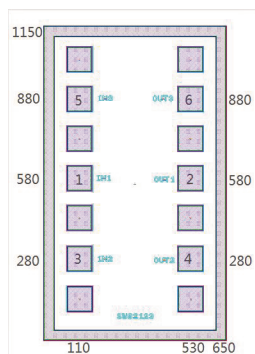
通道	频率范围GHz	衰减量dB	衰减平坦度dB	回波损耗
	GHz	dB	dB	dB min
RF1-RF2	DC-40	1	± 0.4	26
RF3-RF4		2	± 0.4	26
RF5-RF6		3	± 0.2	26

使用限制参数

项目	数值
最高输入功率	+27 dBm
工作温度	-55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$
储存温度	-65 ~ +150 $^{\circ}\text{C}$

*超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏

键合点定义



说明

1. 单位： μm
2. 键合压点尺寸：100X110 μm
3. 芯片背面镀金接地
4. 外形尺寸公差： $\pm 50\mu\text{m}$



该产品对静电较敏感
使用中请注意防静电

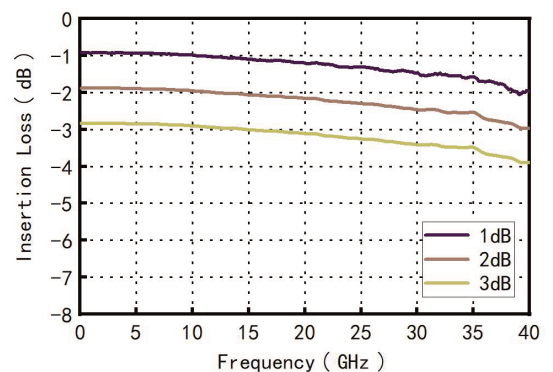
管脚	名称	描述
1、2	RF1、RF2	RF端口, 阻抗50 Ω , 1dB, 不需外接隔直电容
3、4	RF3、RF4	RF端口, 阻抗50 Ω , 2dB, 不需外接隔直电容
5、6	RF5、RF6	RF端口, 阻抗50 Ω , 3dB, 不需外接隔直电容
芯片底部	GND	芯片底部需要与射频及直流接地良好

装配说明:

1. 芯片厚度100 μm 。
2. 在净化环境装配使用, 不要碰触表面, 以免损伤芯片。
3. 输入输出使用2根金丝键合 (直径25 μm), 键合线尽量短, 不要长于400 μm 。
4. 用Au80Sn20 金锡烧结, 温度不要超过300 $^{\circ}\text{C}$, 烧结时间不要超过30秒。
5. 本品属于静电敏感器件, 储存和使用时注意防静电。
6. 干燥、氮气环境下保存。

典型测试曲线

损耗 VS 频率



输入/输出回波损耗VS 频率

